Расчет волнового сопротивления в САПР Altium Designer

Кухарук В.С.

Введение

В современных устройствах сигналы смещаются в область все более высоких частот, сокращается фронт сигнала (1 нс и менее), повышается быстродействие (десятки ГГц). Этот факт требует применения печатных плат (ПП) с контролируемым импедансом – для предотвращения искажений сигнала при передаче его по проводникам.

Проводник на ПП – это уже не просто дорожка, связывающая контактные площадки и переходные отверстия, а линия передачи (ЛП), которая должна передавать сигнал с малыми потерями формы, амплитуды и скорости.

При проектировании ПП, разработчик должен определить, в каких слоях располагаются проводники (или дифференциальные пары) с контролем импеданса, а в каких слоях - опорные полигоны земли и питания. Задача разработчика - провести предварительные вычисления структуры печатной платы и спроектировать ее с учетом рассчитанных значений ширины проводника в заданных слоях.

Современная САПР для проектирования ПП должна поддерживать различные структуры ЛП, учитывать, как можно больше параметров, которые могут повлиять на расчет импеданса. Калькулятор импеданса должен использовать максимально точные формулы для расчета.

Контролируемый импеданс на ПП поднимает на новый уровень сам процесс проектирования, выбора материала, структуры, а также производство печатных плат.

Преимущества калькулятора импеданса в Altium Designer

- Использование библиотеки материалов
- Расчет линий передач для нескольких значений импеданса (в том числе на одном слое)
- Автоматический расчет импеданса
- Представление полной информации о ЛП, включая состав слоев с параметрами и конструкцией ЛП (взаимосвязь стека ПП и ЛП)
- Расчет для разных конструкций линий: одиночных, дифференциальных и копланарных
- Поддержка различных структур линий:
 - микрополосковые это внешние слои
 - полосковые линии которые находятся внутри стека, в том числе и несимметричные.
 - заглубленные слой который может быть покрыт диэлектриком с внешней стороны
- Поддержка нескольких диэлектриков с разными толщинами и разной диэлектрической проницаемостью (Dk)
- Учет бокового подтрава проводника
- Учет толщины маски над проводником и над платой
- Выбор модели и параметров шероховатости
- Расчет задержки ЛП
- Расчет индуктивности ЛП
- Расчет емкости ЛП

Пример расчета импеданса для ЛП

Проектируя ПП с контролируемым волновым сопротивлением разработчику необходимо свести к минимуму затраты на изготовление, поэтому уже на начальной стадии инженер ориентируется на определенные параметры толщины проводника и зазора. Далее под выбранные параметры разработчик старается подобрать материалы и стек печатной платы. Ниже приведен пример, как можно это сделать, используя LSM и расчет импеданса. Стоит отметить, что возможна и обратная ситуация в проектах, когда стек является константой и пользователь должен определить ширину проводника и зазор.

Пример:

Необходимо спроектировать микрополосковые дифференциальные ЛП на внешних слоях в составе 6 слойной платы. Даны исходные параметры линии:

- ширина линии 0,2 мм
- зазор между линиями 0.2 мм
- импеданс 100 Ом, допуск не более 5%

Необходимо подобрать материалы для стека.

1. Загрузить стек ПП 6 слоев в LSM.

<u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> e	lp		
t <u>L</u> ayer Stack Visua	lizer		
<u>M</u> aterial Library			
Features		۶.	
Presets		۶.	2 Layers (2 x Signal, 0 x Plane)
Measurement Un	iits	•	4 Layers (2 x Signal, 2 x Plane)
" Create Via Types I	From Used Vias		6 Layers (4 x Signal, 2 x Plane)
	inai v	.03	8 Layers (6 x Signal, 2 x Plane)
Die	electric 0).32	10 Layers (6 x Signal, 4 x Plane)
🛄 Sig	inal O	.03	12 Lavers (6 x Signal, 6 x Plane)
r Resist 🛛 📼 So	lder Mask 0).01	14 Lavers (9 x Signal, 6 x Diane)
Ov	erlay		14 Cayers (o x Signal, o x Plane)
			16 Layers (8 x Signal, 8 x Plane)

2. Переключить систему единиц на мм



3. Через панель **Panels**, которая находится внизу - слева рабочей области, выбрать панель **Properties**. Данная панель должна быть всегда открыта при работе в LSM.



4. Выбрать вкладку Impedance в LSM



5. Добавить профиль импеданса



- 6. В панели Properties в разделе Impedance Profile выбрать тип линии Differential
- 7. В поле Target Impedance установить значение целевого импеданса 100
- 8. В поле Target Tolerance установить допуск расчета 5



9. Выбрать слой, в котором будет располагаться ЛП. Для примера нужно указать **1 слой (Тор Layer)** в профиле импеданса, при этом подсветятся все слои в стеке, которые участвуют в расчете данной ЛП (отображаются состав и параметры ЛП). В профиле импеданса в колонке **Bottom Ref** - выбрать ближайший опорный слой **2 - Int1 (GND)**.

В панели Properties в разделе Transmission Line, отображается выбранная конструкция ЛП.



10. Отключить Слои **3-Int2 (Sign)** и **4-Int3 (Sign)** в профиле, так как исходная задача предполагает посчитать только микрополосковые ЛП.

D100	+ 💼					
Top Ref	Bottom Ref	Width (W1)				
	2 - Int1 (GND)	0.121mm				
2 - Int1 (GND)	4 - Int3 (Sign)	0.063mm				
	an and (organ)					
3 - Int2 (Sign)	5 - Int4 (PWR)	0.063mm				
5 - Int4 (PWR)		0.121mm				

11. Ставим флаг использования финишного покрытия в панели Properties, для этого в стеки должен присутствовать слой финишного покрытия.

12. В панели **Properties** - изменить ширину линии **W1 = 0.2 мм**, **W2 = 0.18 мм**. **Подтрав (W2)** - боковой подтрав устанавливается в зависимости от технологических особенностей завода.

13. Изменить толщину маски над платой **C1 = 0.03 мм**, над проводником **C2 = 0.025 мм**. Параметр зависит от материала и технологических особенностей завода, как правило толщина маски над диэлектриком и над проводником отличаются.

14. Установить зазор между диф. парами **G = 0.2 мм**.



15. Выбрать другой материал из библиотеки для меди на внешних слоях на значение ½ ог (Thickness = 0.018мм). Так как толщина меди влияет на импеданс, а общая толщина на внешних слоях металлического слоя будет складываться из толщины меди + финишного покрытия, то

возможно изменить толщину меди, чтобы подогнать расчет под заданный импеданс. Если такой материал доступен на заводе.

#	Name	Material	Туре	Weight				Top Ref	Bottom Ref	Width (W1)	Trace Gap (G)	Deviation	Delay (Tp)	Impedance (Zdif
	Top Solder	SM-001	Solder Mask		0.03mm									
	Top Surface Finish	PbSn	 Surface Finish		0.02mm									
1	Top Layer	CF-003	 Signal	1/2oz	0.018mm			2	2 - Int1 (GND)	0.2mm	0.2mm	6.844%	5.929ns/m	93.156
	Dielectric 1	PP-006	Preprog			4.1								
	Dielectric 2	PP-006	Prepreg			4.1					Sel	ect Material		
2	Int1 (GND)	CF-004	 Plane	10-	0.035mm		-	il in um	mm 📩					
	Dielectric 3	Core-035	Core		0,457mm	4.7								
з	Int2 (Sign)	CF-004	Signal		0.035mm			Manufacturer	Name	Thick	ness W	eight	Process	Source
	Dielectric 4	PP-006	Prepreg		0.071mm	4.1		Altium Designer	CF-001	0.009r	nm 1/4	4oz		Altium
	Dielectric 5	PP-006	Prepreg		0.071mm	4.1	2	Altium Designer	CF-002	0.012r	nm 1/:	Boz	ED	Altium
4	Int3 (Sign)	CF-004	Signal		0.035mm		3	Altium Designer	CF-003	0.018r	nm 1/2	2oz	ED	Altium
	Dielectric 6	Core-035	Core		0.457mm	4.7		Altium Designer	CF-004	0.035r	nm 1o	z		Altium
5	Int4 (PWR)	CF-004	Plane		0.035mm			Altium Designer	CF-005	0.07m	m 20			Altium
	Dielectric 7	PP-006	Prepreg		0.071mm	4.1	6	Altium Designer	CF-006	0.105r	nm 3o		ED	Altium

16. Изменить препрег для слоя Dielectric 2 на **PP-014** (Thickness = 0.107 и Dk = 4.2). Также на расчет импеданса в большей степени влияет толщина диэлектрика, ширина проводника и в меньшей степени параметр Dk. В данном примере нужно поднять уровень импеданса, при этом ширину проводника менять не можем. Самое простое решение использовать более толстый диэлектрик. Конечно инженеру необходимо постоянно контактировать с заводом, чтобы материал был в наличии и такое решение было технологичным.

											D100)	+					
#	Name	Material		Туре		Weight	Thickr	ess	Dk		Top Ref		Bottom Ref	Width (W1)	Trace Gap (G)	Deviation	Delay (Tp)	Impedance (Zd
	Top Solder	SM-001		Solder Mask			0.03mr	n										
	Top Surface Finish	PbSn		Surface Finish			0.02mr	h I										
1	Top Layer	CF-003	-	Signal	i		0.018m						2 - Int1 (GND	0.2mm	0.2mm	0.638%	5.89ns/m	100.638
		PP-006					0.071m		4.1									
	Dielectric 2	PP-014		Prepreg			0.107m		4.2									
2	Int1 (GND)	CF-004		Plane					_	_		\$	alact Material					×
	Dielectric 3	Core-035		Core								36						
3	Int2 (Sign)	CF-004		Signal	mil		um m	m ᅌ										
	Dielectric 4	PP-006		Prepreg														
	Dielectric 5	PP-006		Prepreg	≠ M	lanufactur	rer I	lame	-	Thic	kness	Con	structions	Resin	Frequency	Dk		Df
4	Int3 (Sign)	CF-004		Signal 1	1 Re	ezonit	ŀ	R4 HiTg17	70	0.19	1mm	7628	MR	46%	1MHz	5.14		0.018
	Dielectric 6	Core-035		Core	2 Af	tium Desi	gner I	P-001		0.050	U8mm	106		72%	1GHz	3.9		0.02
5	Int4 (PWR)	CF-004		Plane	3 AN	tium Desi	gner i	P-002		0.050	642mm	106		75%	IGHZ	3.8		0.02
	Dielectric 7	PP-014		Prepreg	4 All	tium Desi	gner r	P-005		0.050	604mm	1067		759/	16H2	2.9		0.02
	Dielectric 8	PP-006		Prepreg	5 AB	tium Desi	gner i	P-004		0.000	858mm	1007		62%	16Hz	3.0 // 1		0.02
6	Bottom Layer	CF-003		Signal	7 AH	tium Desi	aner F	P-005		0.00	112mm	1080	,)	62%	1GHz	41		0.02
	Bottom Surface Finish	PbSn		Surface	8 Al	tium Desi	aner F	P-007		0.076	62mm	1086	;	61%	1GHz	4.2		0.02
	Bottom Solder	SM-001		Solder M	9 Ali	tium Desi	gner F	P-008		0.078	874mm	1080		65%	1GHz	4.1		0.02
					0 Alt	tium Desi	- gner F	P-009		0.08	382mm	1078		68%	1GHz			0.02
					1 Alt	tium Desi	gner F	P-010		0.08	636mm	1080		68%	1GHz			0.02
					2 Alf	tium Desi	gner F	P-011		0.08	636mm	1086		65%	1GHz	4.1		0.02
					3 Alt	tium Desi	gner F	P-012		0.09	652mm	1086		68%	1GHz			0.02
					4 Alt	tium Desi	gner F	P-013		0.09	652mm	2113		56%	1GHz	4.3		0.02
				2	5 Alt	tium Desi	gner F	P-014		0.10	67mm	2113	;	60%	1GHz	4.2		0.02
					6 Alf	tium Desi	gner F	P-015		0.11	18mm	3313		60%	1GHz	4.3		0.02
					7 Al	tium Desi	gner F	P-016		0.110	68mm	2116		53%	1GHz	4.4		0.02
					8 Al	tium Desi	gner F	P-017		0.129	95mm	2116			1GHz	4.3		0.02
					9 Al	tium Desi	gner F	P-018		0.15	24mm	1652		60%	1GHz	4.3		0.02
				3	0 AH	tium Desi	gner F	P-019		0.16	51mm	1506		48%	1GHz	4.5		0.02
				3	1 Al	tium Desi	gner F	P-020		0.172	27mm	1506		50%	1GHz	4.5		0.02
				3	2 Al	tium Desi	gner F	P-021		0.180	U3mm	7628		43%	1GHz	4.7		0.02
																		Cancel

17. В панели Properties, в разделе Other - задать модель и параметры шероховатости. Для примера настройки шероховатости меди использовать Model Type - Huray-Bracken, SR=0,2, RF=2. Данный параметр задается для высокоскоростных линий передач.

Roughness	
Model Type	Huray-Bracken 👻
Surface Roughness (SR) [um]	0.2µm
Roughness Factor (RF)	2 \$

18. Вид вкладки Импеданса после изменений всех расчетов



19. Итоговый расчет импеданса

Параметры	Описание	Zdiff (расчетное)
Все параметры учтены (базовый расчет)	Заданное значение импеданса: Zdiff = 100Oм Параметры стека: H1 = 0.107 мм, Dk1 = 4.2, H2 = 0.071 мм, Dk2 = 4.1, T=0.038 мм, W1 = 0.2 mm. W2 = 0.18 мм, Trace Gap (G) = 0.2 мм, Surface Finish = 0.02 мм Паяльная маска: C1 = 0.03 мм, C2 = 0.025 мм, CDk = 4 Шероховатость: Model Type-Huray-Bracken, SR=0.2мкм, RF=2	Zdiff = 100.8 Ом
Маска одной высоты	C1=C2=0.03 мм, другие параметры без изменений по сравнению с базовым расчетом	Zdiff = 100.7 Ом
Без учета шероховатости меди	Если тип модели = Flat Conductors and SR=0.1мкм, другие параметры без изменений по сравнению с базовым расчетом	Zdiff = 100.6Ом
Без учета бокового подтрава	Если W2 = 0.2 мм, другие параметры без изменений по сравнению с базовым расчетом	Zdiff = 98.6Ом
Без учета финишного покрытия	Surface Finish параметр отключен, другие параметры без изменений по сравнению с базовым расчетом	Zdiff = 105.1 Ом

	Name	Material	Туре	Weight	Thickness		Top Ref	Bottom Ref	Width (W1)		Impedance (Zdiff)	Deviation	Delay (Tp)	Use Surface Finish	*5 if n	io use SF	
			Overlay											Trace Inverted			
	Top Solder	SM-001	Surface Finish		0.03mm C1	4 CDk								Etch (inv)	-0.263		
1	Top Layer	CF-003	Signal	1/2oz	0.018mm			2 - Int1 (GND)	0.2mm	0.2mm	100.799	0.799%	5.9ns/m	Width (W1)	0.2mm		
	Dielectric 1	PP-006	Prepreg		0.071mm H2	4.1 Dk2								Width (W2)	0.18mm	*4 if W2 = 0.2 mm	x)
	Dielectric 2		· Prepreg		0.107mm H1	42-0k1								Covering (C1)	0.03mm		
2	Int1 (GND)	CF-004	Plane	1oz	0.035mm		$\langle \rangle$							Covering (C2)	0.025mm	*2 if C2 = 0.03 mm	
										\geq				Trace Gap	0.2mm	f	
														Impedance (Zdiff) Deviation Delay (Tp) Inductance Capacitance	100.799 0.799% 5.9ns/m 594.698nH/m 58.529pF/m	*1 default value Zdiff = 100.8 *2 then Zdiff = 100.7 *3 then Zdiff = 100.6 *4 then Zdiff = 98.6 *5 then Zdiff = 105.1	
									W1					▶ Board			
														₄ Other			
														Roughness			
															Model Type	Huray-Bracken *3 if Hat Conductors	21
														Surface Roughn	ess (SR) [um]	0.2µm *3 if 0.1um	
														Roughnes	s Factor (RF)	2	

Сравнение основных калькуляторов по функциональным возможностям

Nº	Параметры	Altium Designer	High End Calc	Embedded in CAD PCB Calc	Online Calc
1	Полосковые/микрополосковые ЛП	V	V	V	V
2	Библиотека материалов	V	-	-	V
3	Взаимосвязь стека и ЛП	V	-	V	-
4	Копланарные ЛП	V	V	-	-
5	Диэлектрики с разными толщинами и разным Dk	V	V	V	-
6	Расчет подтрава проводника	V	V	V	-
7	Расчет толщины маски над проводником и над пратой	V	V	-	-
8	Возможно выбрать модель и задать параметры шероховатости	V	V	V	-
9	Цена	Бесплатно	\$\$\$	\$	Бесплатно
10	Поставка	В составе САПР ПП	Отдельное ПО	В составе САПР ПП	Веб- страница

Сравнение основных калькуляторов по точности вычисления

Исходные данные:

- Модель и значения шероховатости для меди не задается. В AD используются модель по умолчанию Flat Conductors (SR=0,1um, RF=2).
- Т высота меди с учетом финишного покрытия (мм)
- Н высота диэлектрика (мм), 1,2,3... нумерация диэлектриков снизу-вверх в ЛП
- Dk диэлектрическая постоянная, 1,2,3... нумерация соответствующих диэлектриков
- W1 ширина линии без учета подтрава (мм)
- W2 ширина линии с учетом подтрава (мм)
- С1 толщина маски над диэлектриком (мм)
- С2 толщина маски над проводником (мм)
- G Зазор между линиями в диф. паре (мм)
- S зазор до опорного слоя для копланарных линий (мм)

Пример



Nº	Тип линии передачи и исходные данные	Altium Designer	High End Calc	Embedded in CAD PCB Calc	Online Calc						
		Значение импеданса									
Од)диночная ЛП (целевой импеданс = 50 Ом)										
1	T=0.055 H1=0.1 Dk1 = 4.6 W1=0.16 W2=0.14	50.34	49.35	49.7	49.52 (без W2)						
2	T=0.055 H1=0.1 Dk1=4.5 W1=0.14 W2=0.12 C1=0.03 C2=0.02 CDk=4	50.05	49.52	49 C1=C2= 0.03	48.46 (без W2,С1, CDk)						
3	T=0.055 H1=0.08 Dk1=4.2 H2=0.12 Dk2=4.4 H3=0.1 Dk3= 4.6 W1=0.5 W2=0.48 C1=0.03 C2=0.02 CDk=4	50.07	не поддерживается	49.9 C1=C2= 0.03	не поддерживается						
4	T=0.035 H1=0.2 Dk1=4.2 H2=0.2 Dk2=4.2 W1=0.3 W2=0.2	49.85	49.74	49.4	48.68 (без W2)						

5	T=0.035 H1=0.2 Dk1=4.4 H2=0.2 Dk2=4.4 W1=0.15 W2=0.13	W2 ++ + W1	50.11	50.80	49	47.89 (без W2)
6	T=0.035 H1=0.18 Dk1=4 H2=0.16 Dk2=4.2 H3=0.14 Dk3= 4.4 H4=0.12 Dk3= 4.6 W1=0.13 W2=0.11	W2 W2 W1	50.40	не поддерживается	49.4	не поддерживается
Дис	фференциа	льная ЛП (целевой и	импеданс = 10	00 Ом)		
2	T=0.055 H1=0.2 Dk1=4 W1=0.14 W2=0.12 C1=0.03 C2=0.02 CDk=4 G=0.13	W2 G C2 C1	99.99	99.58	99.5 C1=C2= 0.03	105.74 (без W2,С1, CDk)
Од	иночная ког	лланарная ЛП (целев	вой импеданс	= 50 Ом)		
3	T=0.055 H1=0.17 Dk1=4.5 W1=0.14 W2=0.12 C1=0.03 C2=0.02 CDk=4 S=0.1	S W2 C1 C2 W1	50.07	50.24	не поддерживается	не поддерживается
Дис	фференциа	льная копланарная Ј	ЛП (целевой і	импеданс = 100 Ом	1)	
3	T=0.055 H1=0.5 Dk1=4.3 W1=0.16 W2=0.14 C1=0.03 C2=0.02 CDk=4 S=0.1 G=0.2	S W2 G C1 C2 W1	99.90	100.2	не поддерживается	не поддерживается

Выводы

- Для проектирования высокоскоростных и высокочастотных устройств современная САПР должна поддерживать различные структуры ЛП. В отличие от других программ АD поддерживает большинство из них.
- Для точного расчета волнового сопротивления необходимо учитывать различные параметры, такие как: высота маски, подтрав, шероховатость, что особенно актуально для высокоскоростных устройств. АD в полной мере позволяет это делать.
- Расчет импеданса ЛП происходит в составе всего стека, что позволяет инженеру видеть картину в целом.
- Волновое сопротивление во многом зависит от материала. Такие параметры как содержание смолы, плотность сетки влияют на диэлектрическую проницаемость, а значит и на импеданс. Применение библиотеки позволяет быстро подобрать необходимый материал и тем самым сократить время проектирования структуры линии передачи.
- При проектировании аппаратуры с контролируемым волновым сопротивлением используют расчеты, позволяющие прогнозировать емкость и индуктивность, от которых зависит волновое сопротивление. Формулы, используемые в AD, основаны на эмпирических зависимостях и уникальны для различных конфигураций.